

- [6] Пузрев В.А., Герасимова А.С. // Зарубежная радиоэлектроника. 1989. № 4. С. 56-76.
- [7] Маллер Р., Кейминс Т. Элементы интегральных схем. М., 1989. 630 с.

Научно-исследовательский
институт технического стекла,
Москва

Поступило в Редакцию
1 августа 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 17, вып. 2

26 января 1991 г.

05.4

© 1991

ВОЛЬТАМПЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕПЛОВАЯ
НЕУСТОЙЧИВОСТЬ В ОБЛАСТИ РЕЗИСТИВНОГО
СОСТОЯНИЯ ВТСП КЕРАМИК $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$

Т.А. Игнатьева, А.Н. Великодный,
М.А. Тихоновский

Отличительной чертой ВТСП керамик являются высокие значения температуры сверхпроводящего перехода (T_c) и сравнительно небольшие критические токи (I_c) при азотных температурах.

Критические токи (I_c) ограничиваются слабыми связями между отдельными зернами [1]. Их природа определяет чувствительность критических параметров ВТСП керамик, в частности I_c , к магнитным полям и температуре.

Одним из методов изучения природы разрушения сверхпроводимости ВТСП керамик как под влиянием магнитных полей, так и транспортных токов является анализ ВАХ.

В данной работе исследованы ВАХ образцов из керамики $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$, приготовленных обычной керамической технологией. Типичная ВАХ для одного из образцов с $\rho_{300K} = 2.6 \cdot 10^{-3}$ Ом·см,

$I_c = 160$ А/см² и $T_c \sim 91$ К, содержащая характерные особенности, приведена на рис. 1, а. Как видно из рисунка, на ВАХ наблюдаются две особенности, связанные с появлением резистивного состояния в слабых связях при разрушении ВТСП током. Одна из них – нелинейность начального участка ВАХ в интервале токов от I_c до $1.6 I_c$, другая – неустойчивость при токах более $1.6 I_c$, которая заканчивается резким срывом в устойчивое состояние при токе I^* . Устойчивая часть ВАХ при $I > I^*$ имеет нелинейный характер, а для наиболее одиородных образцов близкий к линейному вплоть до теплового срыва, сопровождающегося расплавлением образца при токах (15–20) I_c .

На рис. 1, б приведены измерения температуры образца относительно азота $\Delta T = T_{\text{обр}} - 77$ К в зависимости от транспорт-

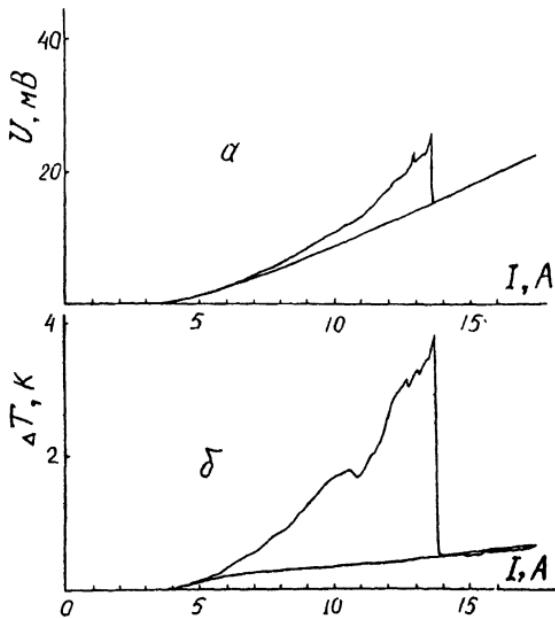


Рис. 1. а) Вольтамперная характеристика. б) Температура образца относительно 77 К в зависимости от транспортного тока.

ногого тока. Возможность измерения температуры образца и отсутствие теплоныеделений на токовых контактах обеспечивались хорошим качеством серебряных контактов с переходным сопротивлением 10^{-8} Ом·см². Температура измерялась с помощью медь-константновой темпорары. Одновременные измерения ВАХ и ΔT (рис. 1, а, б) позволяют наблюдать корреляцию неустойчивости ВАХ с перегревом образца. Это свидетельствует о тепловом характере наблюдаемой особенности. Рассмотрим подробнее особенности ВАХ.

Ранее было показано, что нелинейность начального участка ВАХ очень чувствительна к слабым магнитным полям [2], что обусловлено джозефсоновской природой слабых связей [1]. В силу их неоднородности (разориентация зерен, протяженность границ, возможность наличия другой фазы и т.д.) имеется целый набор значений I_{ki} – критических токов джозефсоновских переходов и постепенное достижение их значений при увеличении тока приводит к нелинейности начального участка ВАХ в интервале $I_k \div 1.6 k$. Эта часть ВАХ хорошо описывается степенной зависимостью $U \sim I^n$, что, по-видимому, связано с переколяционным характером протекания тока. Для различных образцов $n = 3.7-4$, что согласуется с данными [3]. В интервале токов (1.6–2.2) I_k ВАХ лучше описывается не степенной функцией, а экспонентой, далее при увеличении тока начинаются флюктуации на ВАХ вплоть до скачка. При разрушении джозефсоновских связей межзеренные участки переходят в смешанное состояние с надкритическим током $I > I_k$ и появляется нормальная компонента джозефсоновского тока. Появление резистивного

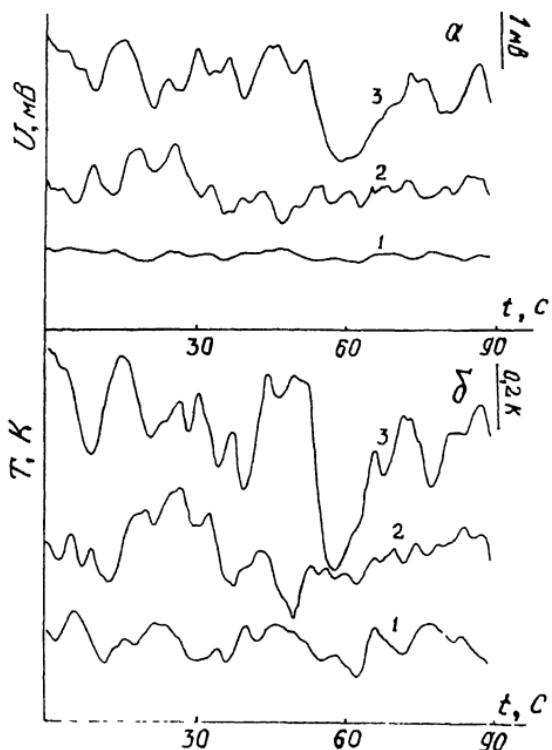


Рис. 2. а) Флуктуации ВАХ при токах: 1 - 8 А, 2 - 11 А, 3 - 12 А.
б) Флуктуации температуры образца при токах: 1 - 8 А, 2 - 11 А, 3 - 12 А.

состояния в слабых связях до $I < 1.6 I_K$ не приводит к заметному разогреву образца. Эта часть ВАХ не имеет гистерезиса (см. рис. 1, а, б).

При дальнейшем увеличении тока, теплоизделия в слабых связях в силу их неоднородности, плохой теплопроводности образца и низкой теплообменной способности среды не успевают выравниваться по образцу. Это приводит к покачательным перегревам образца и появлению 2-й особенности на ВАХ – тепловой неустойчивости в интервале токов (2.2–5) I_K (для приведенного образца). Эта часть ВАХ имеет гистерезис (см. рис. 1, а, б). Достаточно низкое дифференциальное сопротивление образца $\rho = \frac{dV}{dI}$ до скачка на ВАХ (на 1–2 порядка ниже ρ_{300K}), а также низкие значения поля тока в приведенной области ВАХ до 30 э « $H_K I$ » зерна приводят к выводу, что наблюдаемая тепловая неустойчивость в этой области резистивного состояния относится к слабым связям.

Мы предполагаем, что здесь начинает играть роль перераспределение тока между нормальным и сверхпроводящими областями слабых связей, а их сопротивление изменяется в соответствии с изменениями температуры. Может быть и другая точка зрения –

нестационарность теплоотвода. В этой области проявляются флюктуации ВАХ (сопротивления) образца и его температуры при постоянном измерительном токе от времени. Результаты представлены на рис. 2, откуда видно, что при значениях тока, близких к скачку, флюктуации усиливаются.

Для этой области характерным является перегрев образца относительно азота. Максимальная величина ΔT в области скачка достигает для различных образцов (1-4) К. По визуальным наблюдениям в момент скачка вдали от токовых контактов происходит по-кальное вскипание азота около образца – переход от конвективного характера теплообмена к пузырьковому. При этом тепло начинает интенсивнее отводиться от образца за счет резкого увеличения коэффициента теплоотдачи $\alpha = \frac{Q}{\Delta T}$, где Q – тепло, отводимое с единицы поверхности, $\Delta T = (T_{\text{обр}} - 77)$ К. Из наших экспериментов следует, что в области конвективного теплообмена, предшествующего скачку на ВАХ, коэффициент α вначале растет, затем медленно уменьшается с ростом ΔT (область неустойчивости), в момент скачка резко увеличивается, а после скачка – линейно растет.

Таким образом, тепловую неустойчивость ВАХ необходимо рассматривать, учитывая взаимосвязь тепловыделений в образце с теплоотводящей средой.

Изменение характера теплообмена может привести к исчезновению неустойчивости на ВАХ. При измерениях азоте это происходит при вскипании азота – переходе на устойчивую ветвь ВАХ. Если же образец поместить в теплообменную среду с коэффициентом теплопроводности на порядок больше, чем у азота, то неустойчивость на ВАХ отсутствует (нет скачка) вплоть до теплового разрушения сверхпроводимости зерен. Амплитуда флюктуаций на ВАХ значительно уменьшается. Такой результат был получен при помещении образца в среду замороженного 15%-го раствора спирта в воде.

Таким образом, мы наблюдали тепловую неустойчивость и флюктуации на ВАХ в области резистивного состояния слабых связей ВТСП керамики, которые чувствительны как к неоднородности слабых связей, так и к условиям теплообмена с окружающей средой. Учитывая сложную электродинамику ВТСП керамик, можно провести аналогию со сверхпроводниками 2-го рода $S-N-S$ структуры [4] и предположить, что в области резистивного состояния, где наблюдается тепловая неустойчивость, возникают тепловые домены, связанные с неоднородным саморазогревом образца.

Список литературы

- [1] Peterson R.L., Ekin J.W. // Physica C. 1989. V. 157. P. 325-333.
- [2] Игнатьева Т.А., Великодный А.Н., Черняк Н.А., Прядкин Б.К., Тихоновский М.А.,

- О п е к с и е н к о М.М. Тез. докл. 1 Всес. сов. по высокотемпературной сверхпроводимости, Харьков, 1988. Т.1. С. 199.
- [3] А л е к с а н д р о в К.С., В а с и л ь е в А.Д., З в я ги н ц е в С.А., П е т р о в М.И., Х р у с т а л е в Б.П. Препринт ИФАН № 475Ф, Красноярск, 1988.
- [4] Г у р е в и ч А.В., М и н ц Р.Г., Р а х м а н о в А.К. Физика композитных сверхпроводников. М.: Наука, 1987.

Харьковский физико-технический
институт

Поступило в Редакцию
11 июня 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 17, вып. 2

26 января 1991 г.

05.1; 05.2

© 1991

ВАН-ДЕР-ВААЛЬСОВСКИЕ ДИСПЕРСИОННЫЕ СИЛЫ МЕЖДУ ПЛАСТИНКАМИ ИЗ СЕЛЕНИДА ГАЛЛИЯ

Т.Р. М а х т и е в, В.П. Р а д и о н о в,
А.М. А п и е в

Характерной особенностью кристаллического строения селенида галлия является слоистость. Слой предстают собой пакеты плотно упакованных монослоев, расположенных в последовательности анион-катион-катион-анион ($Se - Ga - Ga - Se$), связанных сильными ионно-ковалентными взаимодействиями. Взаимодействия между слоями слабые, в основном Ван-дер-Ваальсовского типа. Последнее утверждение является недостаточно обоснованным, поскольку среди опубликованных работ отсутствуют сообщения о теоретических либо экспериментальных исследованиях Ван-дер-Ваальсовского взаимодействия в селениде галлия. В данной публикации приводятся результаты соответствующих исследований, проведенных на образцах $Se-GaSe$ при $T = 300$ К в вакууме. Методика эксперимента достаточно хорошо описана в работах [1, 2]. Точность измерения зазора между пластинками селенида галлия около 0,2 нм и обеспечивалась использованием оптического интерферометра. Толщина использованных пластинок $GaSe$ – 1 мкм, радиус кривизны цилиндра $R = 1$ см. Результаты экспериментов представлены на рисунке. В двойном логарифмическом масштабе приведена зависимость критического расстояния H -скачки от величины c/R , где

c – жесткость пружины. Зависимость представляет собой пересечение двух наклонных прямых, отражающих две возможные ситуации Ван-дер-Ваальсовского взаимодействия: $H \ll \lambda_0$ и $H \geq \lambda_0$, где λ_0 – характерная длина волны. В первом случае наклон прямой определяется константой Хамакера A , которая, как следует из рисунка, в данном случае равна $4.9 \cdot 10^{-12}$ эрг. Во втором случае существенными становятся эффекты запаздывания, и наклон прямой определя-